


<div><div><div>CIME</div><div>nanotech</div><div></div></div><div>PLANNING SALLE BLANCHE 2016 2ème SEMESTRE 2015-2016</div><div>maj 25/01/2016</div></div>															
AVRIL 2016				MAI 2016				JUIN 2016							
DATE	FORMATION		TP SEANCE	Gr	DATE	FORMATION		TP SEANCE	Gr	DATE	FORMATION		TP SEANCE	Gr	
1	V	M	PHELMA FAME		1	D	M			1	M	M			
	AM		PHELMA FAME			AM					AM				
2	S	M			2	L	M			2	J	M			
	AM					AM					AM				
3	D	M			3	M	M			3	V	M			
	AM					AM					AM				
4	L	M			4	M	M			4	S	M			
	AM					AM					AM				
5	M	M	N@S		5	J	M	ascension		5	D	M			
	AM		N@S			AM					AM				
6	M	M	PHELMA NANOTECH	MEMS S3/4	6	V	M			6	L	M			
	AM		PHELMA NANOTECH	MEMS S4/4		AM					AM				
7	J	M	high tech U		7	S	M			7	M	M			
	AM		high tech U			AM					AM				
8	V	M	PHELMA FAME		8	D	M			8	M	M			
	AM		PHELMA FAME			AM					AM				
9	S	M			9	L	M			9	J	M	IUT MEPHY ALT		
	AM					AM					AM		IUT MEPHY ALT		
10	D	M			10	M	M	polytech nice	MOSTEC S2/4	10	V	M	IUT MEPHY ALT		
	AM					AM		polytech nice	MOSTEC S3/4		AM		IUT MEPHY ALT		
11	L	M			11	M	M	polytech nice	MOSTEC S4/4	11	S	M			
	AM					AM					AM				
12	M	M			12	J	M	polytech nice	MOSTEC S2/4	12	D	M			
	AM					AM		polytech nice	MOSTEC S3/4		AM				
13	M	M	PHELMA NANOTECH	MEMS S1/4	13	V	M	polytech nice	MOSTEC S4/4	13	L	M			
	AM		PHELMA NANOTECH	MEMS S2/4		AM					AM				
14	J	M			14	S	M			14	M	M	Summer School	PV S1/4	1 et 2
	AM					AM					AM		Summer School	PV S2/4	1 et 2
15	V	M			15	D	M			15	M	M	Summer School	PV S3/4	1 et 2
	AM					AM					AM		Summer School	PV S4/4	1 et 2
16	S	M			16	L	M			16	J	M	Summer School	PV S1/4	3 et 4
	AM					AM					AM		Summer School	PV S2/4	3 et 4
17	D	M			17	M	M	ENSGI	CAPA S1/2	1 et 2	17	V	M		
	AM					AM		ENSGI	CAPA S2/2	1 et 2		AM			
18	L	M			18	M	M			18	S	M			
	AM					AM					AM				
19	M	M			19	J	M	ENSGI	CAPA S1/2	3 et 4	19	D	M		
	AM					AM		ENSGI	CAPA S2/2	3 et 4		AM			
20	M	M			20	V	M			20	L	M			
	AM					AM					AM				
21	J	M			21	S	M			21	M	M	Summer School	PV S3/4	3 et 4
	AM					AM					AM		Summer School	PV S4/4	3 et 4
22	V	M			22	D	M			22	M	M	Summer School	PV S1/4	5 et 6
	AM					AM					AM		Summer School	PV S2/4	5 et 6
23	S	M			23	L	M			23	J	M	Summer School	PV S3/4	5 et 6
	AM					AM					AM		Summer School	PV S4/4	5 et 6
24	D	M			24	M	M	TEMPUS INSA	MEMS S1/4	1 et 2	24	V	M		
	AM					AM		TEMPUS INSA	MEMS S2/4	1 et 2		AM			
25	L	M	Lpro IUT Chimie	biopuce S1	25	M	M	TEMPUS INSA	MEMS S3/4	1 et 2	25	S	M		
	AM			1 gp		AM		TEMPUS INSA	MEMS S4/4	1 et 2		AM			
26	M	M			26	J	M	N@S			26	D	M		
	AM					AM		N@S				AM			
27	M	M	PHELMA NANOTECH	MEMS S3/4	27	V	M			27	L	M			
	AM		PHELMA NANOTECH	MEMS S4/4		AM					AM				
28	J	M	Lpro IUT Chimie	CAPA S1/2	28	S	M			28	M	M	Summer School	PV S1/4	
	AM		Lpro IUT Chimie	CAPA S2/2		AM					AM		Summer School	PV S2/4	
29	V	M			29	D	M			29	M	M	Summer School	PV S3/4	
	AM					AM					AM		Summer School	PV S4/4	
30	S	M			30	L	M			30	J	M	N@S classe Allemande		
	AM					AM					AM		N@S classe Allemande		
					31	M	M								
						AM									

<div> salle blanche séances TP et équipements utilisés </div>											
légende											
équipements utilisés											
chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage	diff P	ellipso	profilo		
MOSTEC S1/4	nettoyage +dryox										
MOSTEC S2/4	photolithographie Six + RIE										
MOSTEC S3/4	implant+nett+recuit										
MOSTEC S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al										
équipements utilisés											
MEMS S1/4	photolithographie Si poly										
MEMS S2/4	dopage / implantation + recuit										
MEMS S3/4	alu+SOI-PR+BOE FAR+ litho+etch										
MEMS S4/4	back side alignment + DRIE										
équipements utilisés											
CAPA-DIODE S1/2	nett+dryox+dopage+litho+gravure										
CAPA-DIODE S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu										
équipements utilisés											
MOSTEC S1/5	nettoyage +dryox										
MOSTEC S2/5	photolithographie Six + RIE										
MOSTEC S3/5	dopage / implant+nett+recuit										
MOSTEC S4/5	dépôt LTO et ouverture contacts										
MOSTEC S5/5	dépôt + photolitho +gravure Al										
équipements utilisés											
biopuce S1	LithoOX+etchKOH+nett+wetox										
biopuce S2	hydroxylation										
équipements utilisés											
CAPA S1/2	nett + DRYox										
CAPA S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu										
équipements utilisés											
high tech U S1/2	LITHO avec 2'2 groupes 1h + 1 gp IMEP										
high tech U S2/2	LITHO avec 2'2 groupes 1h + 1 gp IMEP										
équipements utilisés											
PV S1/4	litho+gravure ox+textu+diff Ph										
PV S2/4	désox, nettoyage, dépôt Al										
PV S3/4	RTA, dépôt SiN, photolitho										
PV S4/4	BOE, dépôt alu, lift off										
équipements utilisés											
CHAPRON S1/4	ouvertures ZA + implantation										
CHAPRON S2/4	photolitho+grav. Ox. +dryOx TTh										
CHAPRON S3/4	ouverture des contacts										
CHAPRON S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al										
fête de la science						formation continue					
HTU - découverte ING						FC prgm européens					
nano@school						N@S inventaire					
we et jour férié						vacances scolaires					
arrêt technique						FI					
pont						libre					
à confirmer						travaux/contrôles					